

フォトリリースーインテルとマイクロン、世界初の 128Gb NAND と 20nm 技術に基づく 64Gb NAND の量産により、 NAND フラッシュテクノロジーのリーダーシップを強化

新 128Gb デバイスは小型フォームファクタのタブレット、スマートフォン、 SSD、高性能コンピューティングデバイスに最適

ニュースハイライト

-- 20nm 技術に基づく 128Gb MLC NAND デバイスは、両社の従来型 20nm 64Gb NAND デバイス比で容量と性能が 2 倍に

-- インテルとマイクロンは 20nm 技術に基づく 64Gb NAND フラッシュの量産を発表、最先端 NAND 製造プロセス技術により引き続き業界をリード

-- 指先サイズのパッケージに 8 枚のダイを収めた業界初のモノリシック 128Gb パーツは、1 テラビットのデータを記憶可能—ますます高まる薄型製品への期待に応える新たなストレージ標準

--20nm NAND には標準的なフローティングゲート NAND のスケーリング制約を解消する革新的セル構造を初めて採用

2011 年 12 月 7 日、カリフォルニア州サンタクララ、アイダホ州ボイシー (GLOBE NEWSWIRE) -- インテル コーポレーションおよびマイクロンテクノロジー社 (Nasdaq : MU) は本日、NAND フラッシュテクノロジーの新たな標準となる、世界初の 20 ナノメートル (nm) プロセス技術に基づく 128 ギガビット (Gb) のマルチレベルセル (MLC) デバイスを発表しました。また両社は同時に 20nm プロセス技術に基づく 64Gb NAND の量産も発表、NAND プロセス技術におけるリーダーシップをさらに強化します。

本リリースの関連画像はこちらでご覧いただけます。

インテルとマイクロンの開発ジョイントベンチャーである **IM** フラッシュテクノロジー (**IMFT**) が開発した **20nm** 技術 **128Gb** モノリシックデバイスは、8枚のダイを使用して作られた指先サイズのパッケージで、業界で初めて1テラビット (**Tb**) のデータストレージを実現しました。両社の **20nm** 技術に基づく従来型 **64Gb NAND** と比較して、2倍の容量と性能をご提供します。この **128Gb** デバイスは毎秒 **333** メガトランスファー (**MT/s**) のスピードに達する高速の **ONFI3.0** 規格に準拠しており、費用対効果の高いソリッドステートストレージソリューションをお客様にご提供します。

マイクロンの **NAND** ソリューション事業担当副社長である **Glen Hawk** 氏は次のように述べています。「ポータブルデバイスの小型化・薄型化が進むにつれてサーバーの需要も増加し、お客様は革新的な新しいストレージテクノロジーとシステムソリューションを当社に期待しています。当社とインテルのコラボレーションは、今後もそれらのシステム構築に不可欠である優れた **NAND** テクノロジーと専門知識をお届けします。」

また両社は **20nm** プロセス技術における成功の鍵が、従来のアーキテクチャに比べてさらに積極的なセルスケールリングを可能にした革新的な新型セル構造によるものであることも明らかにしました。両社の **20nm** 技術 **NAND** は、業界初の平面セル構造を用いたことにより新しいプロセス技術特有の問題を克服し、旧世代と同等の性能と信頼性を実現しています。この平面セル構造は **NAND** 製造に初めて **Hi-K** メタルゲートスタックを統合させたことで、標準的な **NAND** のフローティングゲートセルのスケールリング制約を解消することに成功しています。

インテルの副社長兼不揮発性メモリソリューション事業部長である **Rob Crooke** 氏は次のように述べています。「インテルとマイクロンの共同開発により **NAND** でのリーダーシップが継続していること、そして私たちの製造チームが大容量、低コスト、コンピューティングに耐える品質の **20nm** 技術 **NAND** デバイスをご提供しながら多くの「初」を獲得していることは大変喜ばしいことです。**IMFT** は平面セル構造と **Hi-K** メタルゲートスタックを利用することで、**NAND** フラッシュメモリソリューションの技術力を向上させ続け、素晴らしい新製品、サービス、フォームファクタを実現していきます。」

高性能 NAND フラッシュデバイスの需要は、データストレージの成長、クラウドへの移行、ポータブルデバイスの急増という相関する3つの市場トレンドにより決まります。デジタルコンテンツの増加に伴って、ユーザーはデータを複数のデバイスで利用し、すべてクラウドで同期させることを期待するようになっていきます。データを効果的にストリームするため、サーバーは NAND がもたらす高性能・高密度のストレージを必要としており、モバイル機器用ストレージはデータへのアクセス増大に伴って成長しています。HD ビデオは劣悪なユーザー体験を避けるために大容量ストレージを必要とするアプリケーションの一例です。高性能・省スペース型ストレージはこれらの開発により、コンテンツを受け取るモバイル機器側とそれを送るストレージサーバー側の両方において絶好の機会を得ることになります。

インテルとマイクロンは、20nm 技術 64Gb NAND フラッシュ製品の立ち上げを12月におこなうことで、2012年には128Gb デバイスへと迅速に移行できると予想しています。128Gb デバイスのサンプル出荷は1月に開始予定で、その後間もなく2012年前半には量産を開始する予定です。この重要な段階が達成されれば、容量およびファブ全体の生産量のさらなる増加が実現し、両社の開発チームは複雑なストレージソリューションの設計や未来のテクノロジーの改良に必要な専門知識を培うことができるでしょう。

## About Micron

### マイクロンについて

Micron Technology, Inc. is one of the world's leading providers of advanced semiconductor solutions. Through its worldwide operations, Micron manufactures and markets a full range of DRAM, NAND and NOR flash memory, as well as other innovative memory technologies, packaging solutions and semiconductor systems for use in leading-edge computing, consumer, networking, embedded and mobile products. Micron's common stock is traded on the NASDAQ under the MU symbol. To learn more about Micron Technology Inc., visit [www.micron.com](http://www.micron.com).

マイクロンテクノロジー社は、先進的な半導体ソリューションを提供する世界的大手企業です。マイクロンは、世界全域での事業活動を通じ、最先端のコンピューター、家電製品、ネットワークング、組み込み製品、モバイル機器などに使用される DRAM、NAND および NOR フラッシュメモリ全般、およびその他の革新的メモリ技術、パッケージングソリューション、半導体システムなどを製造・

販売しています。マイクロンテクノロジー社の普通株式は NASDAQ に MU のコード名で上場取引されています。マイクロンテクノロジー社に関する情報は [www.micron.com](http://www.micron.com) をご覧下さい。

The Micron Technology, Inc. logo is available at <http://www.globenewswire.com/newsroom/prs/?pkgid=6950>

マイクロンテクノロジー社のロゴは、  
<http://www.globenewswire.com/newsroom/prs/?pkgid=6950>  
にて入手可能です。

インテルについて

インテルは、革新的なコンピューティング技術で世界をリードする企業です。インテルは、仕事や生活で利用される様々なコンピューティング機器の基礎となる重要な技術を開発しています。インテルに関する詳細情報は、  
[newsroom.intel.com](http://newsroom.intel.com) および [blogs.intel.com](http://blogs.intel.com) にてご覧いただけます。

Intel および Intel のロゴは、米国およびその他の国におけるインテル コーポレーションの商標です。

\*その他の名称およびブランドは、その他の法人の所有物である場合があります。

©2011 年 Micron Technology, Inc. and Intel Corporation. All rights reserved. 情報は予告なく変更されることがあります。Micron および Micron の軌道ロゴは Micron Technology, Inc. の商標です。このニュースリリースには、20nm 技術に基づく 64Gb および 128Gb NAND デバイスに関する将来予測の記述が含まれています。実際の出来事や結果は、将来予測の記述に含まれる内容と大きく異なる可能性があります。

あります。マイクロンが米証券取引委員会に対し随時提出する連結ベースの書類、具体的にはマイクロン最新のフォーム「10-K」と「10-Q」をご覧ください。これらの書類は、マイクロンによる連結ベースの実際の結果と「将来予測」に記載されたものが大きく異なる原因となり得る重要な要因を含むと共に、それらを特定しています（「特定の要因」を参照）。当社は「将来予測」に示された期待は妥当だと考えておりますが、将来の結果、活動のレベル、実績、あるいは成果を保証するものではありません。

関連画像は Newscom ([www.newscom.com](http://www.newscom.com)) および AP PhotoExpress でもご覧いただけます。

問い合わせ先: Intel:

Deborah Paquin  
For Intel  
916-984-1921  
debpaquin@strategiccom.biz

Dan Snyder  
Intel Corporation  
408-765-6398  
daniel.s.snyder@intel.com

Micron:  
Kiesha Cochrane  
For Micron  
503-471-6822  
Kiesha.Cochrane@edelman.com

Dan Francisco  
Micron Corporation  
208-368-5584  
dfrancisco@micron.com